



君尚
科技
CAS-IGBT

KWFFP15R12NS3

1200V 15A PIM 模块

特征

采用最新沟槽栅场截止型IGBT芯片

集成NTC温度传感器

高可靠性及热稳定性，良好的参数一致性

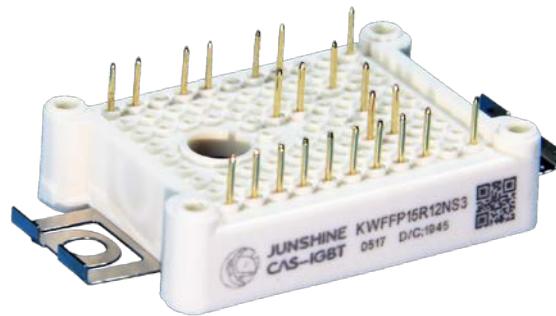
100% RBSOA测试($2*I_{C}$)

低通态损耗($V_{CE}=1.85V$)

低关断损耗($E_{off}=0.71mJ$)

高短路耐量(>10us)

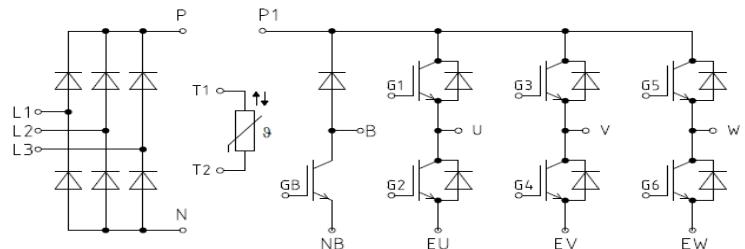
无铅，符合RoHS



应用领域

电机传动

伺服驱动器 等



IGBT(逆变器&制动-斩波器)最大额定值 (未特殊说明时, $T_j=25^{\circ}\text{C}$)

参数	符号	条件	额定值	单位
集电极-发射极耐压	V_{CES}		1200	V
栅极-发射极耐压	V_{GES}		± 20	V
集电极电流	I_C	$T_c=25^{\circ}\text{C}$	30	A
		$T_c=100^{\circ}\text{C}$	15	
集电极重复峰值电流	I_{CRM}	$t_p=1\text{ms}$	30	
总功率损耗	P_{tot}	$T_c=25^{\circ}\text{C}, T_{vj\max}=150^{\circ}\text{C}$	125	W
短路承受时间	t_{SC}	$V_{GE}=15\text{V}, V_{CC}=600\text{V}$ $T_j=150^{\circ}\text{C}$	>10	μs
工作结温	T_{vjop}		-40~150	$^{\circ}\text{C}$

IGBT(逆变器和制动-斩波器)电学特性 (未特殊说明时, $T_j=25^\circ\text{C}$)

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
静态特性						
集电极-发射极击穿电压	$V_{(\text{BR})\text{CES}}$	$V_{\text{GE}}=0\text{V}, I_c=1\text{mA}$	1200	-	-	
导通压降	$V_{\text{CE}(\text{sat})}$	$V_{\text{GE}}=15\text{V}, I_c=15\text{A}$ $T_j=25^\circ\text{C}$ $T_j=150^\circ\text{C}$	-	1.85	-	V
阈值电压	$V_{\text{GE}(\text{th})}$	$I_c=0.6\text{mA}, V_{\text{CE}}=V_{\text{GE}}$	4.7	5.9	6.7	
集电极-发射极漏电流	I_{CES}	$V_{\text{CE}}=1200\text{V}, V_{\text{GE}}=0\text{V}$	-	-	2	mA
栅极-发射极漏电流	I_{GES}	$V_{\text{CE}}=0\text{V}, V_{\text{GE}}=20\text{V}$	-	-	500	nA
动态特性						
输入电容	C_{iss}	$V_{\text{CE}}=25\text{V}$ $V_{\text{GE}}=0\text{V}$ $f=1\text{MHz}$	-	1120	-	
输出电容	C_{oss}		-	91	-	pF
反馈电容	C_{rss}		-	51	-	
栅电荷	Q_g		$V_{\text{CC}}=900\text{V}, I_c=15\text{A}, V_{\text{GE}}=15\text{V}$	-	71	nC
开关特性 (感性负载)						
开通延迟时间	$t_{d(\text{on})}$	$T_j=25^\circ\text{C}$ $V_{\text{CC}}=600\text{V}$ $I_c=15\text{A}$ $V_{\text{GE}}=\pm 15\text{V}$ $R_g=20\Omega$	-	14	-	
上升时间	t_r		-	41	-	ns
关断延迟时间	$t_{d(\text{off})}$		-	135	-	
下降时间	t_f		-	121	-	
开通损耗	E_{on}		-	0.87	-	mJ
关断损耗	E_{off}		-	0.71	-	
开关损耗	E_{ts}		-	1.58	-	
开通延迟时间	$t_{d(\text{on})}$	$T_j=150^\circ\text{C}$ $V_{\text{CC}}=600\text{V}$ $I_c=15\text{A}$ $V_{\text{GE}}=\pm 15\text{V}$ $R_g=20\Omega$	-	13	-	
上升时间	t_r		-	41	-	ns
关断延迟时间	$t_{d(\text{off})}$		-	177	-	
下降时间	t_f		-	183	-	
开通损耗	E_{on}		-	0.92	-	mJ
关断损耗	E_{off}		-	1.01	-	
开关损耗	E_{ts}		-	1.93	-	
集电极短路电流	I_{sc}	$V_{\text{GE}}=15\text{V}, V_{\text{CC}}=600\text{V}, T_j=150^\circ\text{C}$	-	65		A
壳到结的热阻	R_{thJC}	每个IGBT	-	1.00	-	K/W

二极管(逆变器&制动-斩波器)最大额定值 (未特殊说明时, $T_j=25^\circ\text{C}$)

参数	符号	条件	额定值	单位
反向重复峰值电压	V_{RRM}		1200	V
连续正向直流电流	I_F	$T_C=25^\circ\text{C}$	30	A
		$T_C=100^\circ\text{C}$	15	
正向重复峰值电流	I_{FRM}	$t_p=1\text{ms}$	30	
电流时间积分	$I^2 t$	$t_p=10\text{ms}, T_C=100^\circ\text{C}$	-	A^2s
工作结温	T_{vjop}		-40~150	$^\circ\text{C}$

二极管(逆变器&制动-斩波器)电学特性 (未特殊说明时, $T_j=25^\circ\text{C}$)

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
正向压降	V_F	$V_{GE}=0\text{V}, I_F=15\text{A}$ $T_j=25^\circ\text{C}$ $T_j=150^\circ\text{C}$	-	1.85	-	V
反向恢复时间	t_{rr}	$T_j=25^\circ\text{C}$	-	130	-	ns
反向恢复电荷	Q_{rr}	$V_R=600\text{V}, I_F=15\text{A}$	-	1.07	-	μC
反向恢复峰值电流	I_{rrm}	$-di/dt=600\text{A/us}$	-	18.0	-	A
反向恢复时间	t_{rr}	$T_j=150^\circ\text{C}$	-	210	-	ns
反向恢复电荷	Q_{rr}	$V_R=600\text{V}, I_F=15\text{A}$	-	2.15	-	μC
反向恢复峰值电流	I_{rrm}	$-di/dt=600\text{A/us}$	-	22.0	-	A
壳到结的热阻	R_{thJCD}	每个二极管	-	1.6	-	K/W

二极管(整流器)最大额定值 (未特殊说明时, $T_j=25^\circ\text{C}$)

参数	符号	条件	额定值	单位
反向重复峰值电压	V_{RRM}		1600	V
正向平均电流	$I_{F(AV)}$	$T_C=80^\circ\text{C}$	20	A
正向浪涌电流	I_{FSM}	$t_p=10\text{ms}, T_C=150^\circ\text{C}$	250	
电流时间积分	$I^2 t$	$t_p=10\text{ms}, T_C=150^\circ\text{C}$	300	A^2s
工作结温	T_{vjop}		-40~150	$^\circ\text{C}$

二极管(整流器)电学特性 (未特殊说明时, $T_j=25^\circ\text{C}$)

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
反向重复峰值电压	V_{RRM}	$I_R=0.1\text{mA}$	1600	-	-	V
正向压降	V_F	$V_{GE}=0\text{V}, I_F=15\text{A}$ $T_j=25^\circ\text{C}$ $T_j=150^\circ\text{C}$	-	1.05	-	V
反向漏电流	I_R	$V_R=1200\text{V}, T_j=25^\circ\text{C}$	-	-	1	mA
壳到结的热阻	R_{thJCD}	每个二极管	-	1.04	-	K/W

负温度系数热敏电阻

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
额定电阻值	R_{25}	$T_c=25^\circ C$	-	5	-	$k\Omega$
R100偏差	$\Delta R/R$	$T_c=25^\circ C, R_{100}=481\Omega$	tbd	-	tbd	%
耗散功率	P_{25}	$T_c=25^\circ C$	-	tbd	-	mW
B-值	$B_{25/50}$	$R_2=R_{25}\exp[B_{25/50}(1/T_2 - 1/(298.15K))]$	-	3380	-	K
B-值	$B_{25/80}$	$R_2=R_{25}\exp[B_{25/80}(1/T_2 - 1/(298.15K))]$	-	3440	-	K

模块

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
绝缘测试电压	V_{ISOL}	$f = 50Hz, 1minute$	2500	-	-	V
最大结温	$T_{vj\ max}$		-	-	150	$^\circ C$
工作结温	T_j		-40	-	150	$^\circ C$
外壳-散热器热阻	$R_{\theta CS}$	每个模块	-	0.1	-	K/W
储存温度	T_{stg}		-40	-	125	$^\circ C$
模块安装扭距	M	Mounting Screw:M4	1.3	-	1.7	N·m
重量	G		-	24	-	g

输出特性 IGBT, 逆变器&斩波-制动器 (典型)

output characteristic IGBT,

Inverter&Brake-Chopper (typical)

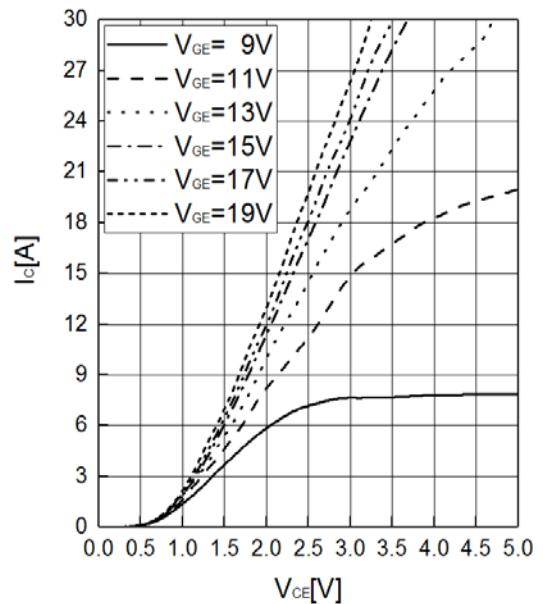
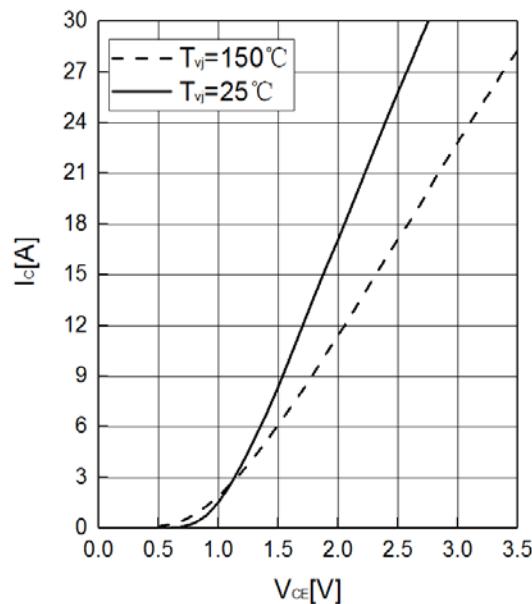
$I_C = f(V_{CE})$, $V_{GE} = 15 \text{ V}$

输出特性 IGBT, 逆变器&斩波-制动器 (典型)

output characteristic IGBT,

Inverter&Brake-Chopper (typical)

$I_C = f(V_{CE})$, $T_j = 150^\circ\text{C}$



传输特性 IGBT, 逆变器&斩波-制动器 (典型)

transfer characteristic IGBT,

Inverter&Brake-Chopper (typical)

$I_C = f(V_{GE})$, $V_{CE} = 20 \text{ V}$

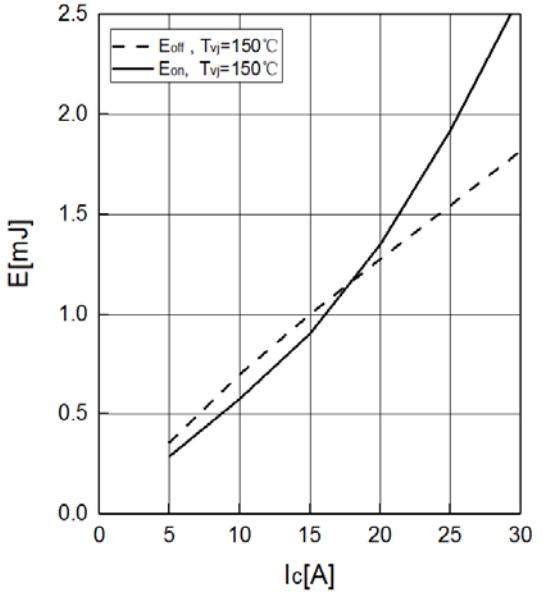
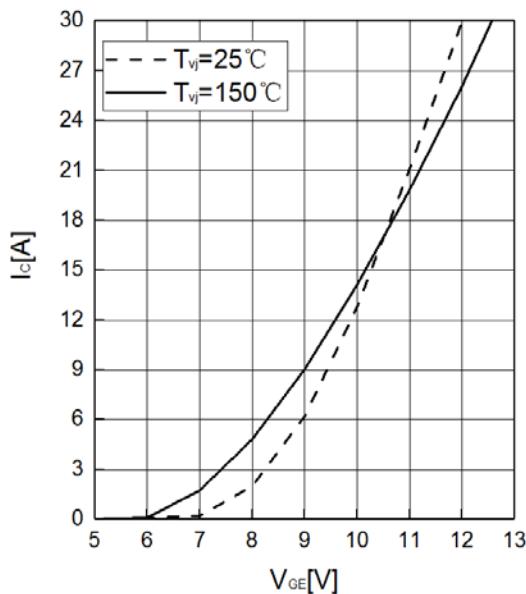
开关损耗 IGBT, 逆变器&斩波-制动器 (典型)

switching losses IGBT,

Inverter&Brake-Chopper (typical)

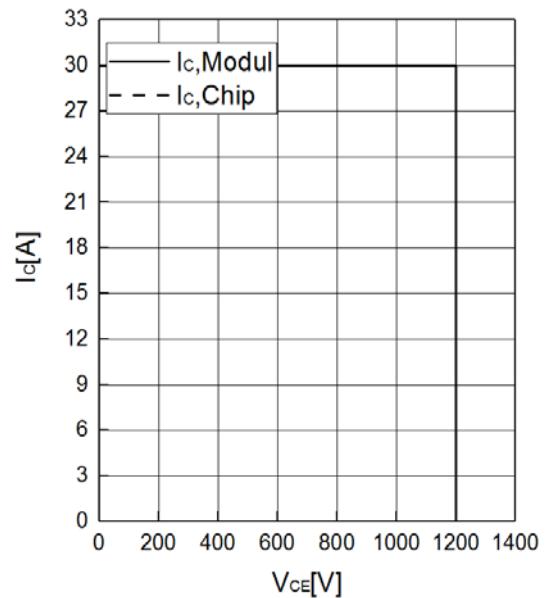
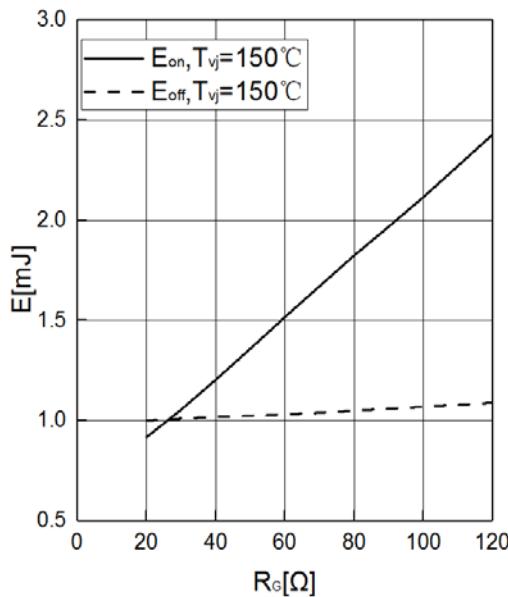
$E_{on} = f(I_C)$, $E_{off} = f(I_C)$

$V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$, $R_{Gon} = 20 \Omega$, $R_{Goff} = 20 \Omega$, $V_{CE} = 600 \text{ V}$



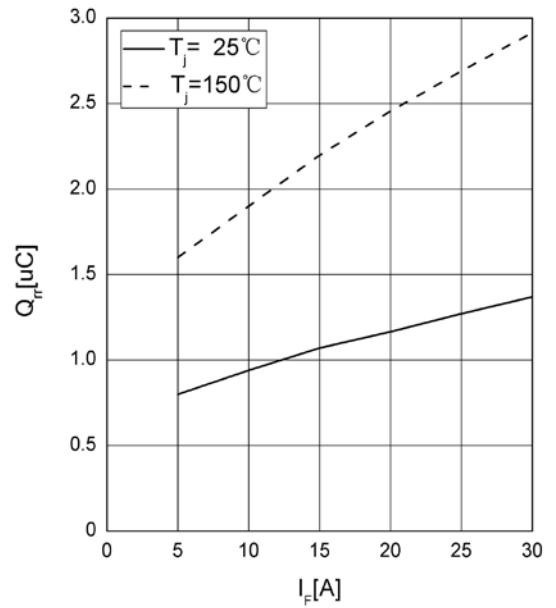
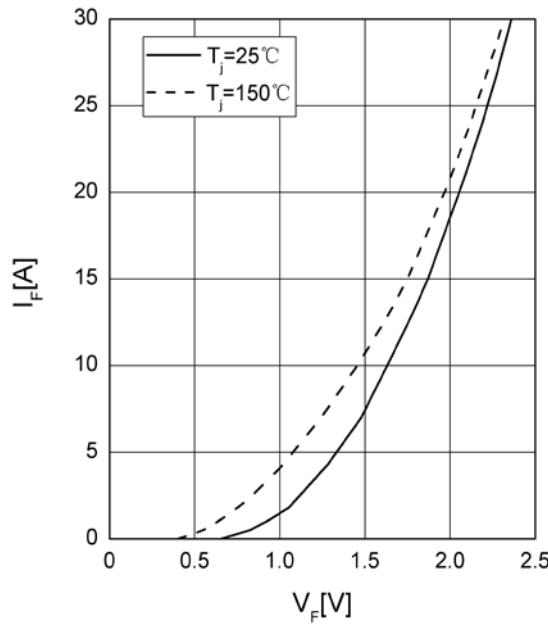
开关损耗 IGBT, 逆变器&斩波-制动器 (典型)
**switching losses IGBT,
 Inverter&Brake-Chopper (typical)**
 $E_{on} = f(R_G)$, $E_{off} = f(R_G)$
 $V_{GE} = \pm 15 V$, $I_C = 15 A$, $V_{CE} = 600 V$

反偏安全工作区 IGBT, 逆变器&斩波-制动器 (RBSOA)
**reverse bias safe operating area IGBT,
 Inverter&Brake-Chopper (typical)**
 $I_C = f(V_{CE})$
 $V_{GE} = \pm 15 V$, $R_{Goff} = 20 \Omega$, $T_j = 150^\circ C$



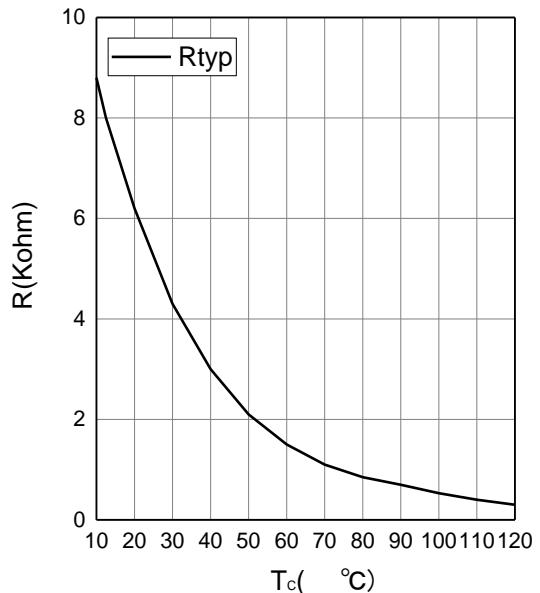
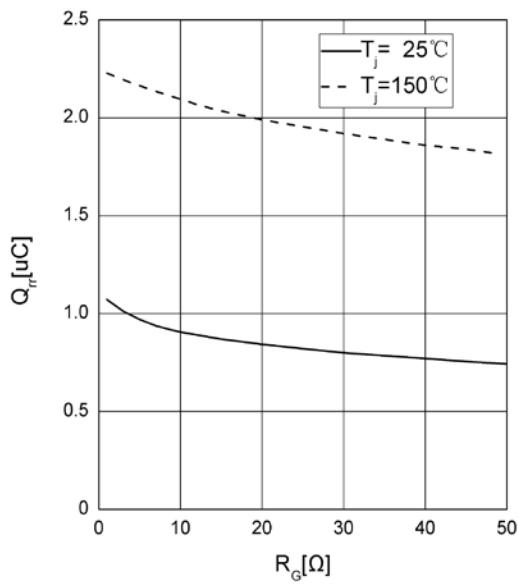
正向偏压特性 二极管, 逆变器&斩波-制动器 (典型)
**forward characteristic of Diode,
 Inverter&Brake-Chopper (typical)**
 $I_F = f(V_F)$

恢复电荷 二极管, 逆变器&斩波-制动器 (典型)
**recovered charge of Diode,
 Inverter&Brake-Chopper (typical)**
 $Q_{RR} = f(I_F)$

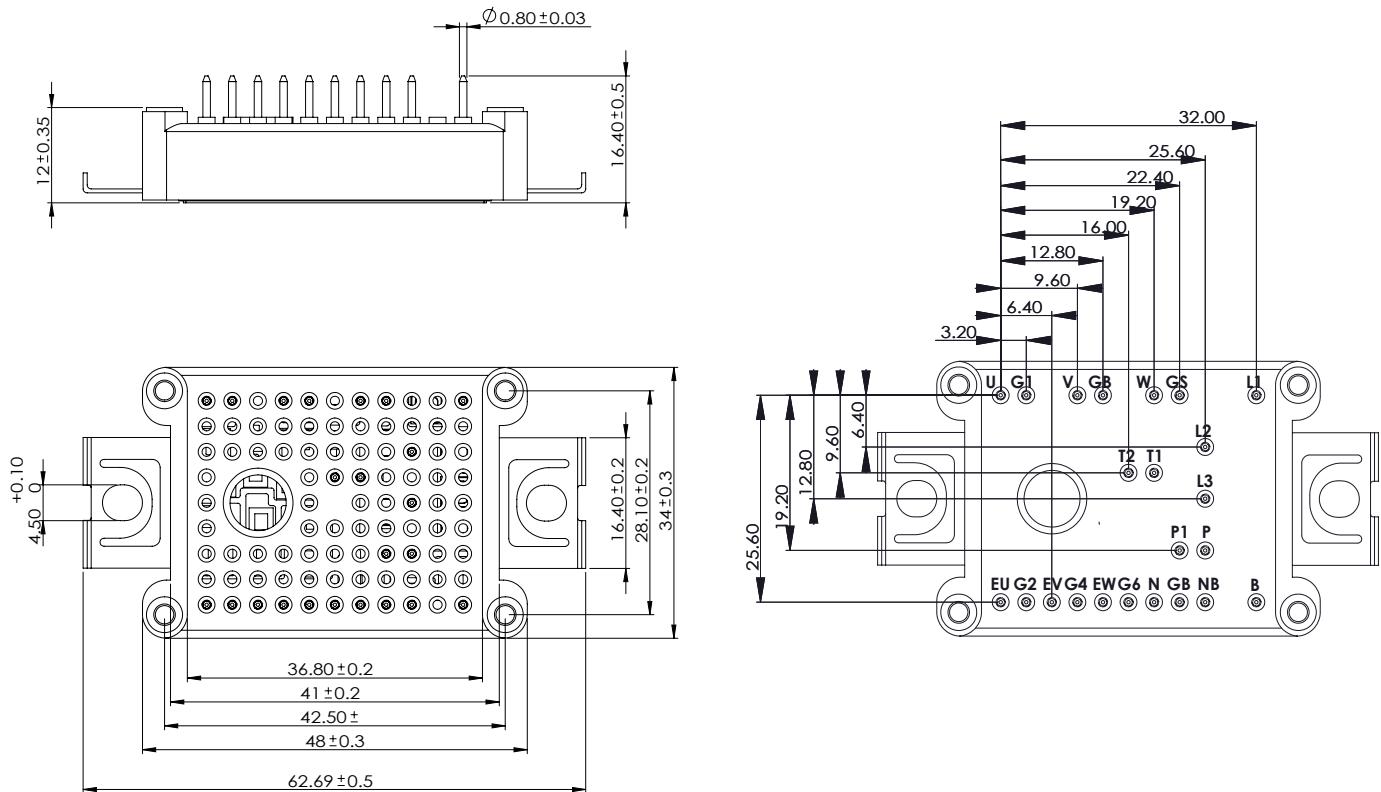


恢复电荷 二极管,逆变器&斩波-制动器 (典型)
 recovered charge of Diode,
 Inverter&Brake-Chopper (typical)
 $Q_{rr} = f(R_G)$, $I_F = 15A$, $V_{CE} = 600V$

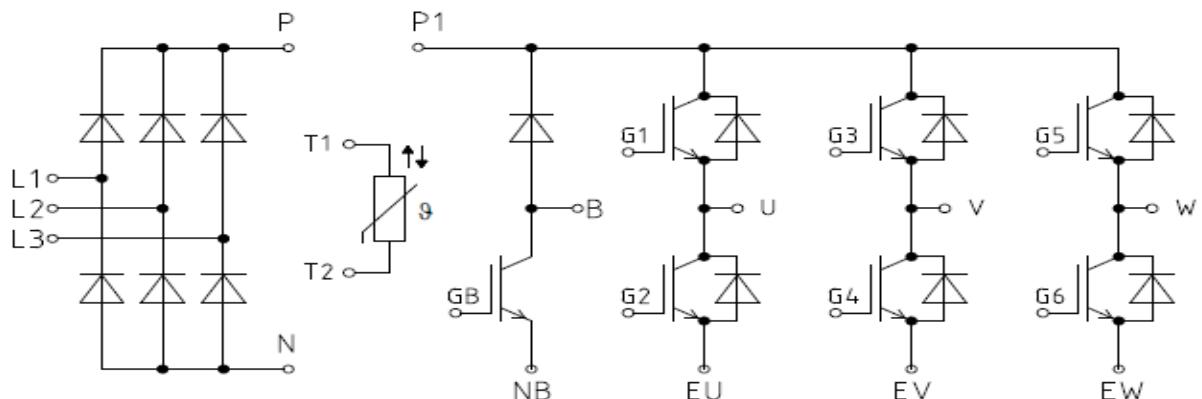
负温度系数热敏电阻 温度特性
 NTC temperature characteristic (typical)
 $R = f(T)$



模块尺寸 (单位: mm)



电路示意图



X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for IGBT Transistors category:

Click to view products by JUNSHINE manufacturer:

Other Similar products are found below :

[748152A](#) [FGH60T65SHD_F155](#) [APT100GT60B2RG](#) [APT13GP120BG](#) [APT20GN60BG](#) [APT20GT60BRDQ1G](#) [APT25GN120B2DQ2G](#)
[APT35GA90BD15](#) [APT36GA60BD15](#) [APT40GP60B2DQ2G](#) [APT40GP90B2DQ2G](#) [APT50GN120B2G](#) [APT50GT60BRG](#)
[APT64GA90B2D30](#) [APT70GR120J](#) [NGTB10N60FG](#) [NGTB30N60L2WG](#) [NGTG25N120FL2WG](#) [IGP30N60H3XKSA1](#) [STGB15H60DF](#)
[STGFW20V60DF](#) [STGFW30V60DF](#) [STGFW40V60F](#) [STGWA25H120DF2](#) [FGB3236_F085](#) [APT25GN120BG](#) [APT25GR120S](#)
[APT30GN60BDQ2G](#) [APT30GN60BG](#) [APT30GP60BG](#) [APT30GS60BRDQ2G](#) [APT30N60BC6](#) [APT35GP120JDQ2](#) [APT36GA60B](#)
[APT45GR65B2DU30](#) [APT50GP60B2DQ2G](#) [APT68GA60B](#) [APT70GR65B](#) [APT70GR65B2SCD30](#) [GT50JR22\(STA1ES\)](#) [TIG058E8-TL-H](#)
[IDW40E65D2](#) [SGB15N120ATMA1](#) [NGTB50N60L2WG](#) [STGB10H60DF](#) [STGB20V60F](#) [STGB40V60F](#) [STGFW80V60F](#)
[IGW40N120H3FKSA1](#) [RJH60D7BDPQ-E0#T2](#)